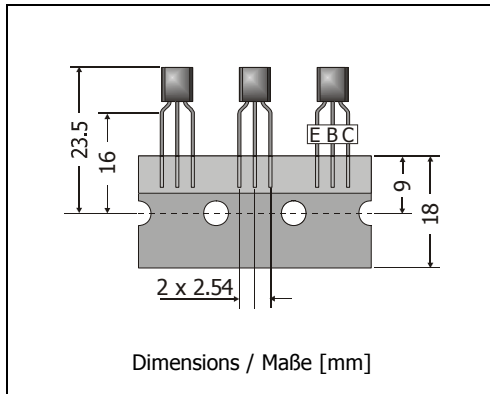


MPSA42 / MPSA43**NPN**
High voltage Si-epitaxial planar transistors
Hochspannungs-Si-Epitaxial Planar-Transistoren
NPN

Version 2005-06-17


Power dissipation
Verlustleistung

625 mW

Plastic case
Kunststoffgehäuse

TO-92
(10D3)

Weight approx.
Gewicht ca.

0.18 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
**Maximum ratings (T_A = 25°C)****Grenzwerte (T_A = 25°C)**

			MPSA42	MPSA43
Collector-Emitter-volt. - Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO}	300 V	200 V
Collector-Base-voltage - Kollektor-Basis-Spannung	E open	V _{CBO}	300 V	200 V
Emitter-Base-voltage - Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EB0}	6 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I _C	500 mA	
Base current – Basisstrom		I _B	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-65...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-65...+150°C	

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

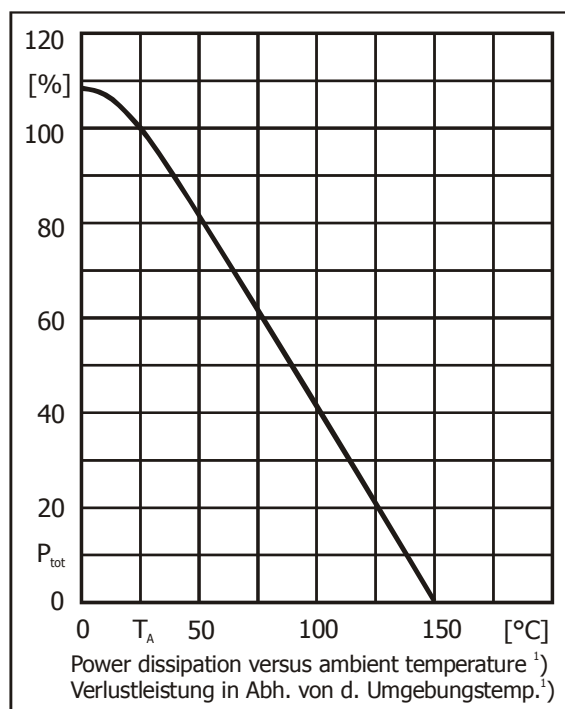
			Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
I _E = 0, V _{CB} = 200 V	MPSA42	I _{CB0}	–	–	100 nA
I _E = 0, V _{CB} = 160 V	MPSA43	I _{CB0}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom					
I _B = 0, V _{EB} = 6 V	MPSA42	I _{EB0}	–	–	100 nA
I _B = 0, V _{EB} = 4 V	MPSA43	I _{EB0}	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ²⁾					
I _C = 20 mA, I _B = 2 mA	MPSA42	V _{CEsat}	–	–	500 mV
	MPSA43	V _{CEsat}	–	–	400 mV

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

2 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics (T _j = 25°C)			Kennwerte (T _j = 25°C)		
			Min.	Typ.	Max.
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾					
I _C = 20 mA, I _B = 2 mA	V _{BEsat}		–	–	0.9 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
V _{CE} = 10 V, I _C = 1 mA	h _{FE}	25	–	–	–
V _{CE} = 10 V, I _C = 10 mA	h _{FE}	40	–	–	–
V _{CE} = 10 V, I _C = 30 mA	h _{FE}	40	–	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
V _{CE} = 20 V, I _C = 10 mA, f = 100 MHz	f _T	50 MHz	–	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
V _{CB} = 20 V, I _E = i _e = 0, f = 1 MHz	MPSA42 MPSA43	C _{CB0} C _{CB0}	– –	– –	3 pF 4 pF
Thermal resistance junction – ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 200 K/W ²⁾		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren			MPSA92, MPSA93		



1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden